

a 2018 0065

Invenția se referă la procedee de obținere a materialelor semiconductoare și poate fi utilizată în tehnologia semiconductoare.

Procedeul, conform invenției, constă în sinterizarea pulberilor de ZnO prin metoda reacției chimice de transport într-un volum închis la o temperatură de sinterizare de 900...1150°C, timp de 48...72 de ore, cu un gradient de temperatură în regiunea de sinterizare de $\leq 10^\circ\text{C}/\text{cm}$ și cu o viteză de răcire a ceramicii obținute de $\leq 100^\circ\text{C}/\text{oră}$. În calitate de agenți de transport se utilizează HCl cu presiunea inițială de 1...6 atm., H₂ cu presiunea inițială de 50...200% din presiunea inițială a HCl, și C în cantitatea de $\leq \text{HCl}$ (mol).

Revendicări: 1

Figuri: 3